

# 2SC2277

シリコン NPN エピタキシャル LTP 形

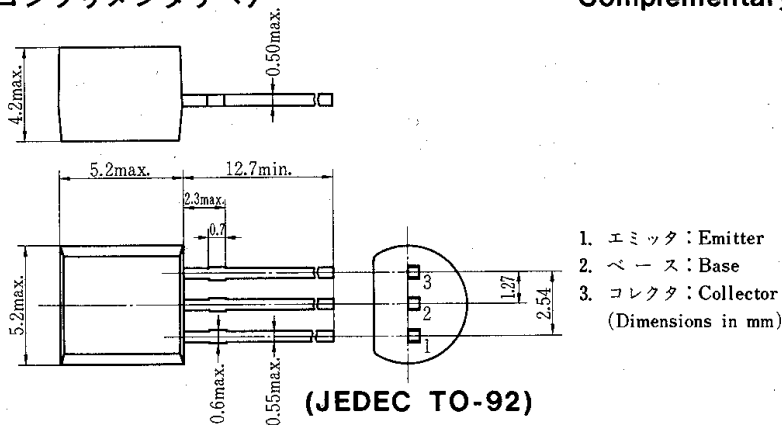
低周波増幅用

2SA993 とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL LTP

LOW FREQUENCY AMPLIFIER

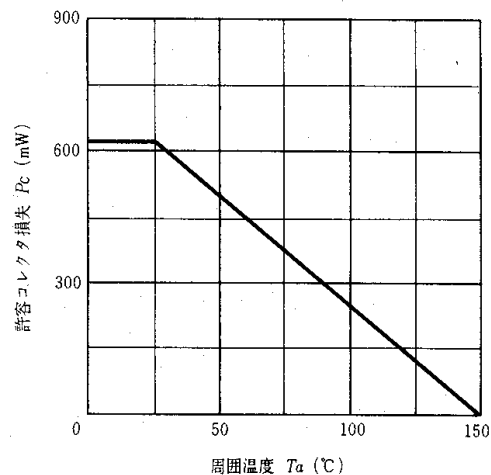
Complementary pair with 2SA993



## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	2SC2277	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	50	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	50	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	500	mA
許容コレクタ損失	$P_C$	625	mW
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+125	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	50	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	50	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=50\text{V}, I_E=0$	—	—	100	nA
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE}=3\text{V}, I_C=150\text{mA}$	60	—	320	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	—	—	0.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$	—	—	0.5	V

\* 2SC2277 は  $h_{FE}$  の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

\* The 2SC2277 is grouped by  $h_{FE}$  as follows.

Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60~120	100~200	160~320